SOT89 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

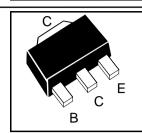
FCX458

ISSUE 3 – OCTOBER 1995

FEATURES

- * 400 Volt V_{CEO}
- * P_{tot}= 1 Watt

COMPLEMENTARY TYPE - FCX558 PARTMARKING DETAIL - N58



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	400	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	I _C	225	mA
Peak Pulse Current	I _{CM}	500	mA
Power Dissipation at T _{amb} =25°C	P _{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T _j :T _{stg}	-65 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

DADAMETED	CVAADOL	NAINI	B 4 A M	LINUT	COMPITIONS
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	400		V	I _C =100μA
	$V_{CEO(sus)}$	400		V	I _C =10mA*
	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E=100\mu A$
Collector Cut-Off Currents	I _{CBO}		100	nA	V _{CB} =320V
	I _{CES}		100	nA	V _{CE} =320V
Emitter Cut-Off Current	I _{EBO}		100	nA	V _{EB} =4V
Emitter Saturation Voltages	V _{CE(sat)}		0.2 0.5	V V	I _C =20mA, I _B =2mA* I _C =50mA, I _B =6mA*
	V _{BE(sat)}		0.9	V	I _C =50mA, I _B =5mA*
Base-Emitter Turn On Voltage	V _{BE(on)}		0.9	V	I _C =50mA, V _{CE} =10V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h _{FE}	100 100 15	300		I _C =1mA, V _{CE} =10V I _C =50mA, V _{CE} =10V* I _C =100mA, V _{CE} =10V**
Transition Frequency	f _T	50		MHz	I _C =10mA, V _{CE} =20V f=20MHz
Collector-Base Breakdown Voltage	C _{obo}		5	pF	V _{CB} =20V, f=1MHz
Switching times	t _{on} t _{off}	135 Typical 2260 Typical		ns ns	I _C =50mA, V _C =100V I _{B1} =5mA, I _{B2} =-10mA

^{*}Measured under pulsed conditions. Pulse width= $300\mu s$. Duty cycle $\leq 2\%$ Spice parameter data is available upon request for this device For typical characteristics graphs see FMMT458 datasheet

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru 4 moschip.ru 9